

第15回半導体材料・デバイスフォーラム プログラム

| セッション | No. | 氏名 | 所属 | 講演タイトル |
|--|-------|---------------------|---|--|
| 開会 | | 石川 洋平 | 有明高専 教授 | |
| 10:05~10:50 基調講演 | | | | |
| 基調講演 | I-1 | 澤田 和明 | 豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 集積電子システム分野 教授 次世代半導体・センサ科学研究所 所長 | 集積化センサ技術が拓く未来 |
| 10:50~12:00 博士学生講演 (発表・質疑込み15分)、学生ショートプレゼン第1会場 (発表3分・質疑無し) | | | | |
| 博士学生講演 | P1-1 | 今村 隆輝 (熊本高専 出身) | 広島大学 大学院 統合生命科学研究科 博士課程1年 | 高分解能ライトフィールド顕微鏡の開発と神経回路動態の計測の応用 |
| ショートプレゼン 第1会場 | P1-1 | 原田 航陽 | 宮崎大学 4年 | 理論計算を用いた多光子励起による発光信号分布の再現 |
| | P1-2 | 小林 歩人 | 木更津工業高等専門学校 専攻科1年 | 太陽電池型中性子線量計の中性子検出特性 |
| | P1-3 | 高江洲 義人 | 九州大学 3年 | RNNを用いたLSIチップ異常検出モデルの検討 |
| | P1-4 | 菊本 翔太 | 熊本高等専門学校 専攻科2年 | 二段階低温熱処理により形成したGeSn 結晶の評価 |
| | P1-5 | 江藤 葉 (熊本高専 出身) | 筑波大学大学院 修士課程1年 | 金属基板選択によるSi薄膜のLiイオン電池負極特性の向上 |
| | P1-6 | 平倉 拓海 (大分高専 出身) | 熊本大学大学院 修士課程1年 | ノーマリーオフ動作を目指した AlGaN バリア層のミストエッチング |
| | P1-7 | 島袋 颯馬 | 沖縄工業高等専門学校 専攻科2年 | イオン注入したSi ₃ N ₄ のマイクロ波加熱効果 |
| | P1-8 | 藤田 直希 | 宮崎大学 4年 | 光ヘテロダイン光熱変位法を用いたGeグラフェン膜における非発光再結合信号のマッピング評価 |
| | P1-9 | 樋口 裕之介 | 九州工業大学大学院 修士課程2年 | 3種類の希釈溶媒によるN極性面GaNのウェットエッチング解析 |
| | P1-10 | 小野 諒子 | 九州工業大学大学院 修士課程1年 | アルカリ溶液を用いたウェット処理がGa ₂ O ₃ 表面形態に及ぼす影響 |
| | P1-11 | 神田 大訓 | 舞鶴工業高等専門学校 5年 | タンタル酸化物を用いた抵抗変化メモリのフォーミング特性評価 |
| | P1-12 | 井 音羽 | 都城工業高等専門学校 専攻科2年 | シラス由来分相多孔質ガラスの製造プロセスの開発と応用製品への発展 |
| | P1-13 | 松田 聖矢 | 熊本高等専門学校 5年 | 半導体材料に特異的に結合できるグルコースオキシダーゼの単離 |
| | P1-14 | 生山 也真登 (有明高専 出身) | 九州大学大学院 修士課程1年 | チタン製歯科インプラントへの適用を目指したナノダイヤモンド被膜の形成 |
| | P1-15 | 渡辺 観侃 (松江高専 出身) | 九州大学大学院 修士課程1年 | 同軸型アークプラズマ堆積法による導電性ナノダイヤモンド粉末の合成 |
| | P1-16 | 内藤 陽大 | 有明工業高等専門学校 専攻科1年 | 光電子制御放電によるプラズマ閉じ込め |
| 11:10~12:00 学生ショートプレゼン第2会場 (発表3分・質疑無し) | | | | |
| ショートプレゼン 第2会場 | P2-1 | 三島 秀治郎 | 九州工業大学大学院 修士課程2年 | エッチング装置のカソード材料が与えるN極性GaNへの影響 |
| | P2-2 | 松川 高介 | 宮崎大学 4年 | 意図的にAgを注入したCu ₂ ZnSnS ₄ 太陽電池の欠陥およびポテンシャル揺らぎ評価 |
| | P2-3 | 高細工 彩斗 | 熊本高等専門学校 専攻科2年 | 絶縁基板上における非晶質Ge薄膜のMg誘起結晶成長(3) |
| | P2-4 | 中坂 元 | 都城工業高等専門学校 専攻科2年 | 酸化チタン光触媒薄膜におけるプラズマ診断に基づく酸化制御因子の解明と基板冷却スバツタ法による低温結晶化 |
| | P2-5 | 田中 光太 (有明高専 出身) | 九州工業大学大学院 修士課程2年 | β-FeSi ₂ メサ型pnホモ接合素子の作製と評価 |
| | P2-6 | 田邊 健人 | 舞鶴工業高等専門学校 5年 | 室温ナノインプリントによるDLC微細パターン形成と半導体人材育成 |
| | P2-7 | 林 巧巳 | 舞鶴工業高等専門学校 5年 | 抵抗変化メモリが示すアナログ抵抗変化特性のシミュレーション |
| | P2-8 | 橋本 壮太郎 | 宮崎大学 4年 | 光ヘテロダイン光熱変位法による鉄汚染させたSi中の鉄濃度測定 |
| | P2-9 | 御園 樹 (久留米高専 出身) | 九州大学大学院 修士課程1年 | ダイヤモンド(111)基板上に成膜したβ-Ga ₂ O ₃ 薄膜の結晶構造および化学結合状態 |
| | P2-10 | 土屋 沙織 | 木更津工業高等専門学校 3年 | スクリーン印刷法による太陽電池型中性子線量計用コンパクター膜の作製と評価 |
| | P2-11 | 松井 隼人 | 木更津工業高等専門学校 専攻科1年 | 大気開放型CVD法によるCdZnSバツファ層の組成制御 |
| | P2-12 | 代永 遼平 | 宮崎大学 4年 | キャリアの緩和過程を考慮した歪緩和層挿入超格子太陽電池のキャリア輸送特性の解析 |
| | P2-13 | 野田 浩矢 | 有明工業高等専門学校 専攻科1年 | ナノドープダイヤモンドライカーボン薄膜の合成と電気特性 |
| | P2-14 | 濱田 仁誠 | 都城工業高等専門学校 専攻科1年 | 配向性を制御したSnO ₂ ガスセンサ薄膜の作製とそのガスセンサ特性 |
| | P2-15 | 金光 鼓太郎 | 久留米工業高等専門学校 専攻科2年 | 熱電気回路網モデルによる複合熱電材料の特性評価の検討 |

| | | | | |
|--|-------|--------------------|-------------------------|--|
| | P2-16 | 森 健太郎 | 都城工業高等専門学校 専攻科1年 | Ag ₃ SnS ₆ 薄膜作製における硫化水素濃度の検討 |
| 11:10~12:00 学生ショートプレゼン第3会場 (発表3分・質疑無し) | | | | |
| ショートプレゼン 第3会場 | P3-1 | 伊藤 玲音 | 筑波大学大学院 修士課程2年 | 多層グラフェンの層交換における合成温度の低温化と負極特性の向上 |
| | P3-2 | 中原 大葉 | 熊本高等専門学校 専攻科2年 | 高圧下熱処理によるMg誘起固相成長Ge薄膜の結晶性向上 |
| | P3-3 | 内田 翔太 | 木更津工業高等専門学校 専攻科1年 | 大気開放型CVD法を用いて作製したCdZnS膜をバッファ層に用いたCdTe太陽電池の高効率化 |
| | P3-4 | 古賀 紀后 | 久留米工業高等専門学校 専攻科2年 | 錯体重合法によるBiZn ₂ VO ₆ の調製とLa添加効果 |
| | P3-5 | 中嶋 まい (八戸高専 出身) | 北陸先端科学技術大学院大学 修士課程2年 | GaSeナリボンの電子照射スイッチング特性のその場TEM計測 |
| | P3-6 | 桶谷 優生 | 都城工業高等専門学校 専攻科2年 | シラスガラス薄膜表面に存在する固体酸が銅担持量に与える影響 |
| | P3-7 | 渡辺 慎太郎 | 舞鶴工業高等専門学校 5年 | ポッティング用シリコーンを用いた液滴ナノインプリントによるDLC膜の微細パターン形成 |
| | P3-8 | 細越 裕太 | 宮崎大学 4年 | 光ヘテロダイナ光熱変位法を用いたSiとAl間の界面熱コンダクタンスの推定 |
| | P3-9 | 時元 康貴 | 九州大学大学院 修士課程2年 | 酸化物半導体IGZOを用いたデュアルゲート薄膜トランジスタ |
| | P3-10 | 森野 達也 | 木更津工業高等専門学校 専攻科1年 | サブストレート型CdTe太陽電池を用いた線量計の開発 |
| | P3-11 | 谷 龍哉 | 九州工業大学大学院 修士課程2年 | 酸化ガリウムのドライエッチングに及ぼすICP-RIE装置のエッチング条件の影響について |
| | P3-12 | 古澤 七音 | 久留米工業高等専門学校 5年 | 錯体重合法によるBiZn ₂ VO ₆ の調製と評価 |
| | P3-13 | 山形 悠太 (呉高専 出身) | 九州工業大学大学院 修士課程1年 | Bi ₂ Se ₃ /CdSe/Bi ₂ Se ₃ 構造のファンデルワールスエピタキシー |
| | P3-14 | 外園 駿介 | 九州大学大学院 修士課程1年 | 成膜時の負バイアス印加が窒素ドーパノダイヤモンド薄膜の電気化学特性に与える影響 |
| | P3-15 | 瀧川 遼太 | 熊本高等専門学校 専攻科1年 | XRD によるステンレス表面の酸化被膜の解析 |
| | P3-16 | 福田 旺士 | 有明工業高等専門学校 専攻科2年 | 光電子制御放電プラズマによるグラフェンの構造制御 |
| 12:00~13:00 昼食 | | | | |
| 13:00~13:25 (説明会25分) | | | | |
| 説明会 | | | | 九州大学工学部・九州沖縄9高専連携教育プログラム 説明会 |
| 13:30~16:00 大学セミナー | | | | |
| 第1会場 | | | | 大学セミナープログラムをご確認ください。 |
| 第2会場 | | | | |
| 13:30~17:00 企業セミナー | | | | |
| A会場 | | | | 企業セミナープログラムをご確認ください。 |
| B会場 | | | | |
| C会場 | | | | |
| D会場 | | | | |
| E会場 | | | | |
| F会場 | | | | |
| G会場 | | | | |
| 16:00~17:40 学生ポスター発表 | | | | |
| 学生ポスター発表 | | | | ポスター発表プログラムをご確認ください。 奇数番号コアタイム：16:10~16:55 偶数番号コアタイム：16:55~17:40 |
| 閉会 | | | | |